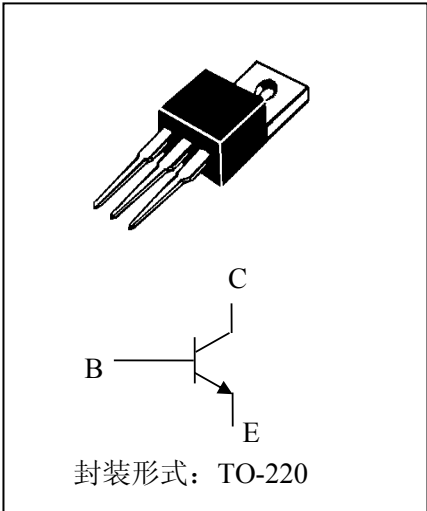


NPN高压开关晶体管/NPN High Switching Transistor

- 特点：■击穿电压稳定■开关速度快■安全工作区宽■符合ROHS规范
- FEATURES:■HIGH VOLTAGE CAPABILITY ■HIGH SPEED SWITCHING ■WIDE SOA ■ROHS COMPLIANT
- 应用■节能灯■电子镇流器■电子变压器等开关电路
- APPLICATION:■FLUORESCENT LAMP ■ELECTRONIC BALLAST ■ELECTRONIC TRANSFORMER ECT.

● 最大额定值 (TC=25℃) Absoolute Maximum Rantings (Tc=25℃)

参数名称 PARAMETER	符号 SYMBOL	额定值 VALUE	单位 UNIT
集电极-基极电压 Collector-Base Voltage	VCBO	700	V
集电极-发射极电压 Collector-Emitter Voltage	VCEO	400	V
发射极-基极 Emitter-Base Voltage	VEBO	9	V
集电极电流 Collector Current	IC	12	A
集电极耗散功率 Total Power Dissipation	PC	100	W
最高工作温度 Junction Temperature	Tj	150	℃
贮存温度 Storage Temperature	TsTg	-65-150	℃



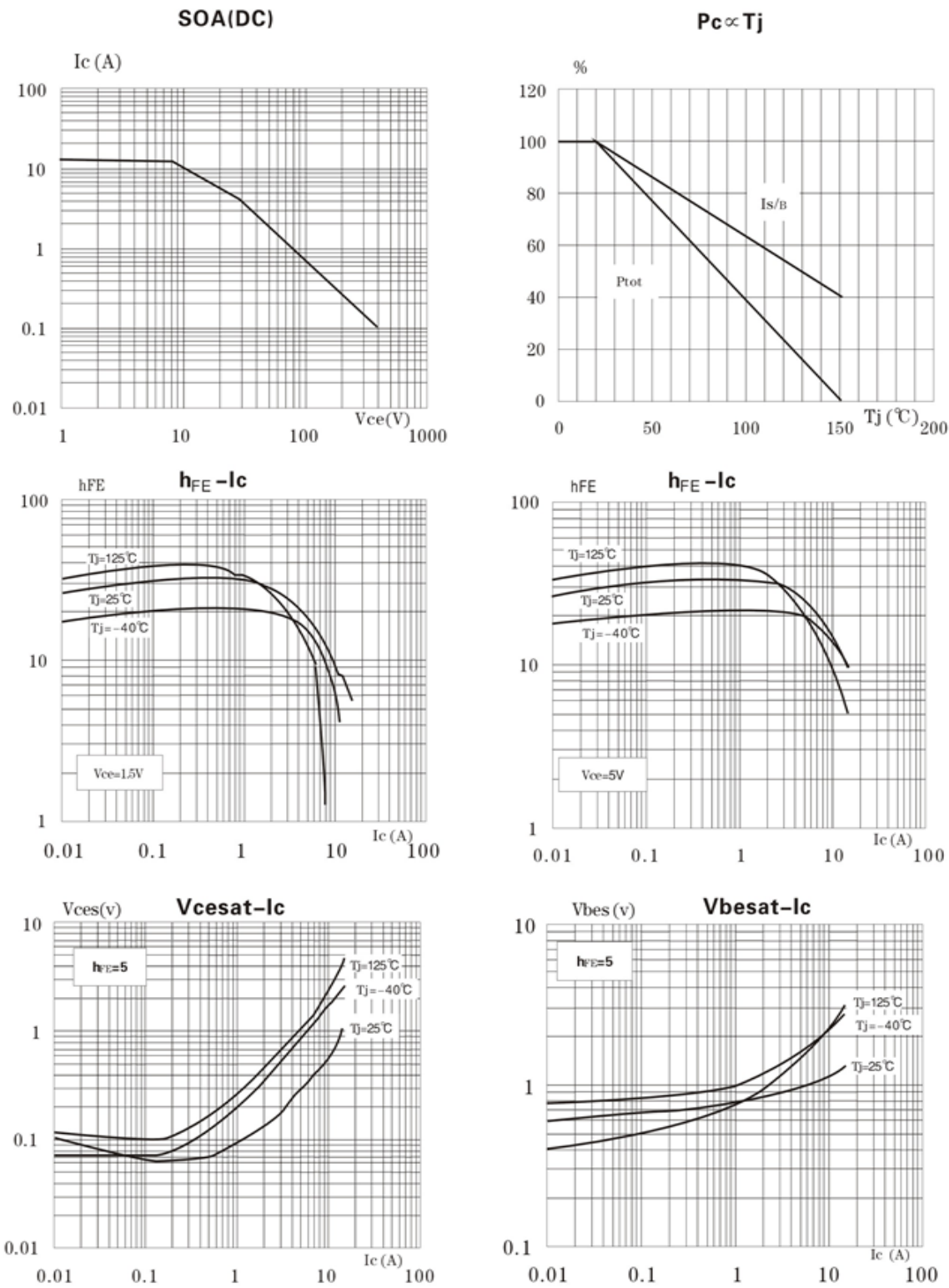
● 电特性 (TC=25℃) Electronic Characteristics (Tc=25℃)

参数名称 CHARACTERISTICS	符号 SYMBOL	测试条件 TEST CONDITION	最小值 MIN	最大值 MAX	单位 UNIT
集电极-基极截止电流 Collector-Base Cutoff Current	ICBO	VCB=700V		5	uA
集电极-发射极截止电流 Collector-Emitter Cutoff Current	ICEO	VCE=400V,IB=0		10	uA
集电极-发射极电压 Collector-Emitter Voltage	VCEO	IC=10mA,IB=0	400		V
发射极-基极电压 Collector-Base Voltage	VEBO	IE=1mA,IC=0	9		V
集电极-发射极饱和和压降 Collector-Emitter Saturation Voltage	Vcesat	IC=2.0A,IB=0.4A		0.3	
		IC=5.0A,IB=1.25A		0.65	V
		IC=8.0A,IB=2.0A		0.85	V
发射极-基极饱和和压降Base-Emitter Saturation Voltage	Vbesat	IC=5.0A,IB=1.25A		1.2	V
电流放大倍数 DC Current Gain	Hfe	VCE=5V,IC=10mA	8		
		VCE=5V,IC=2.0A	20	35	
		VCE=5V,IC=9.0A	6		
贮存时间 Storage Time	ts	VCC=5V IC=0.5A (UI9600)	5.0	8.0	us
下降时间 falling time	tf			0.8	
特征频率	fT	VCE=10V	4	-	MHz
		IC=0.5A			

● 热特性 THERMAL CHARACTERISTICS

项 目 Parameter	符号 Symbol	最小值 Value(min)	最大值 Value(max)	单 位 Unit
结到管壳的热阻 Thermal resistance from junction to case	Rth(j-c)		1.56	℃/W

特性曲线 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (curves)



TO-220 Package Dimensions

UNIT:mm

